

Feature

- § Low Power Consumption
- § I.C. compatible

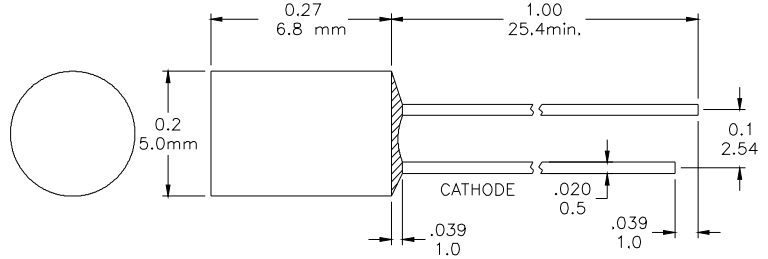
Applications

- § Dot-Matrix Module
- § LED Bulb

Description

- § These LEDs are Based on GaAsP/GaP Material Technology
- § Emitted color: Yellow
- § Water Transparent Lens

Package Dimension



*Tolerance : $\pm \frac{0.01}{0.25}$ Unit : $\pm \frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C

Symbol	Parameter	Max.	Unit
PD	Power Dissipation	120	mW
VR	Reverse Voltage	5	V
IAF	Average Forward Current	30	mA
IPF	Peak Forward Current (Duty=0.1, 1kHz)	100	mA
—	Derating Linear Form 25°C	0.4	mA/°C
Topr	Operating Temperature Range	-40 to + 85	°C
Tstg	Storage Temperature Range	-40 to + 100	°C
Lead Soldering Temperature [1.6mm (0.063inch) From Body] 260°C For 5 Seconds.			

Electrical / Optical Characteristics and Curves at Ta=25°C

Symbol	Parameter	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
VF	Forward Voltage	IF= 20 mA		2.2	2.4	V
IR	Reverse Current	VR= 5 V			100	μA
$\Delta \theta$	Half Intensity Angle	IF= 20 mA		100		Deg.
IV	Luminous Intensity	IF= 20 mA		80		mcd.
λd	Dominant Wavelength	IF= 20 mA		590		nm

Electrical Characteristics at Ta=25°C

Symbol	I _v		V _F		λ D	
Parameter	Luminous Intensity		Forward Voltage		Dominant Wavelength	
Condition	IF=20mA		IF=20mA		IF=20mA	
Unit	mcd		V		nm	
Binning	Grade	Range	Grade	Range	Grade	Range
			C	1.9~2.0	Y3	587~589
			D	2.0~2.1	Y4	589~591
			E	2.1~2.2	Y5	591~593
			F	2.2~2.3		
			G	2.3~2.4		

Intensity: Tolerance of minimum and maximum = ± 15%

V_F: Tolerance of minimum and maximum = ± 0.05v

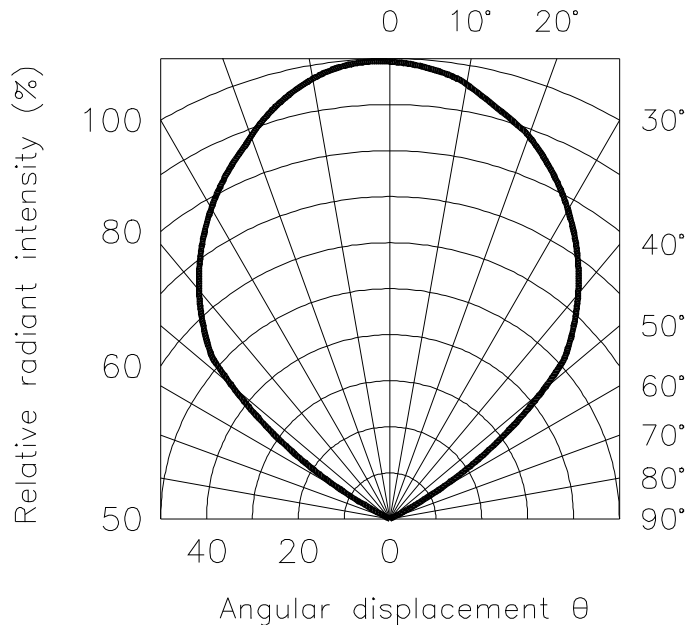
NOTE:

1. Static electricity and surge damages the LED. It is recommend to use a anti-static wrist band or anti-electrostatic glove when handing the LEDs. All devices, equipment and machinery must be properly grounded.
2. Specific binning requirements –please contact our home office

Radiation Diagram

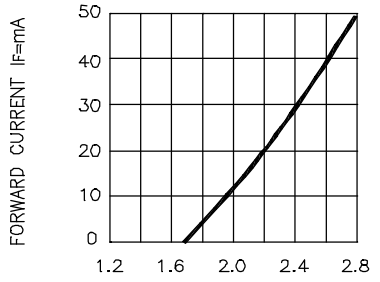
IF=20 mA 50% Power Angle Angle =100°

Radiation Diagram

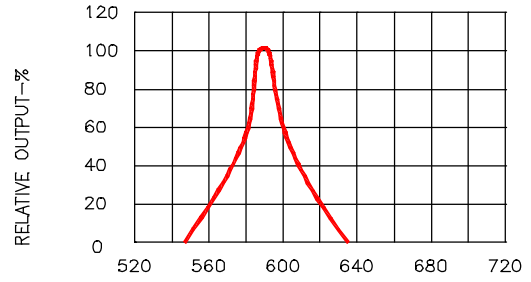


YELLOW

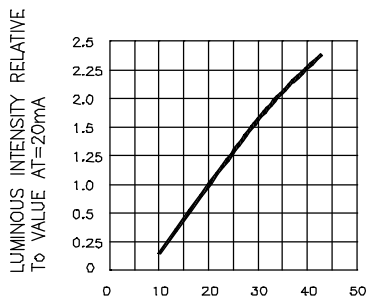
Typical Electro-optical Characteristic Curves (25°C Free Air Temperature Unless Otherwise Specified)



FORWARD VOLTAGE(V_f)—VOLTS
Fig.1 FORWARD CURRENT VS FORWARD VOLTAGE



WAVELENGTH(λ)—nm
Fig.2 SPECTRAL RESPONSE



I_f—FORWARD CURRENT—mA
Fig.3 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

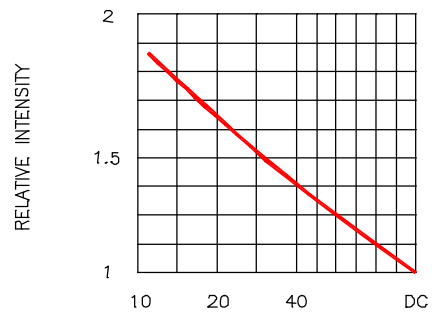
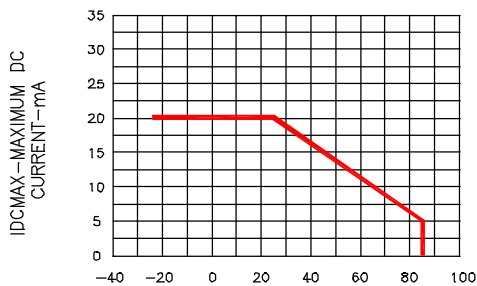


Fig.4 LUMINOUS INTENSITY VS. DUTY CYCLE



T_a AMBIENT TEMPERATURE °C
Fig.5 MAXIMUM ALLOWABLE DC CURRENT PER SEGMENT VS. A FUNCTION OF AMBIENT TEMPERATURE



Fig.6 MAX PEAK CURRENT VS. DUTY CYCLE % (REFRESH RATE f=1KHz)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9